

$$V_{Dsat} = V_G - V_T \quad (4.2)$$

上式中的  $V_{Dsat}$  表示：(1)對照圖 4-4(b)左側，其為夾止點剛好發生在汲極端的汲極電壓。(2)如圖 4-4(b)右側之特性曲線顯示，其為進入飽和區所需的汲極電壓。

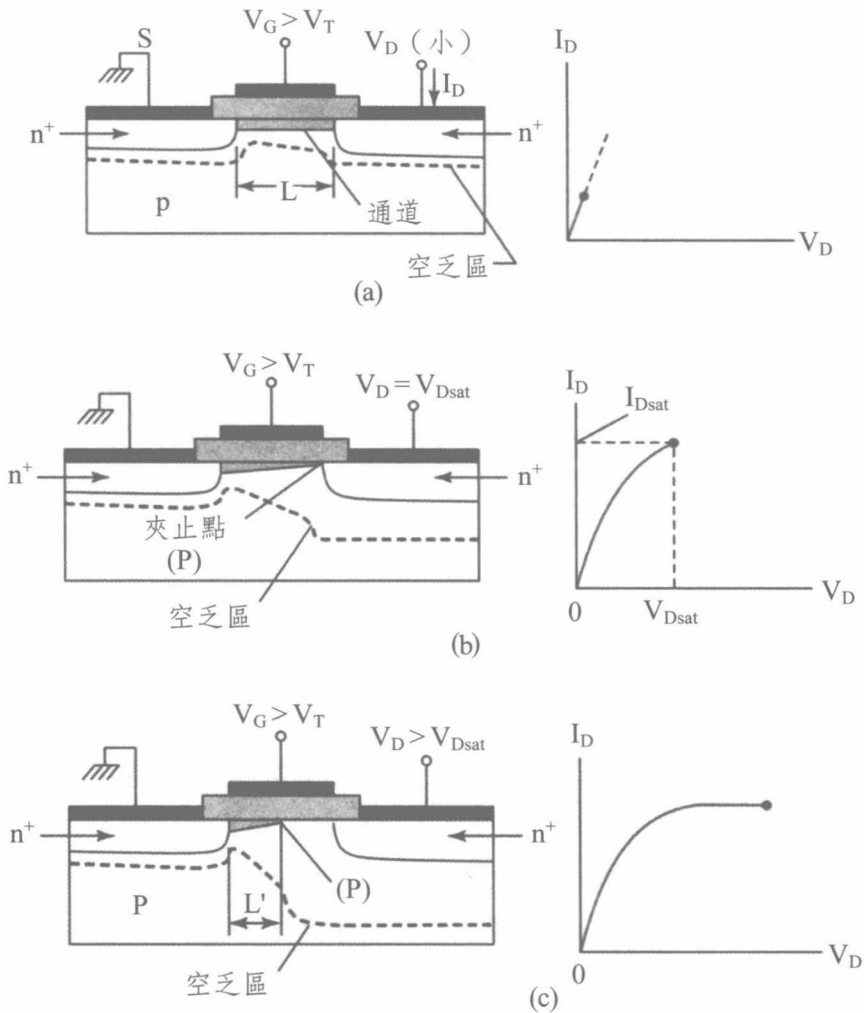


圖 4-4 增強型 n-MOSFET 於  $V_G > V_T$  時之  $I_D - V_D$  特性曲線，當處於(a)小的  $V_D$  值（線性區） (b)  $V_D = V_{Dsat} = V_G - V_T$ （剛進入飽和區） (c)  $V_D > V_{Dsat}$ （飽和區）（取自 Sze[2]）。